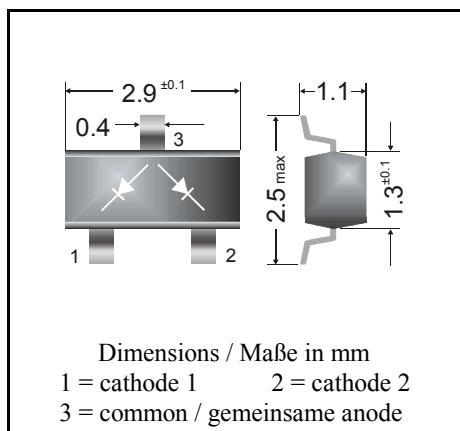


Surface Mount Silicon Planar
Dual Small-Signal Diodes
(common anode)

Silizium-Planar-Doppel-Dioden
für die Oberflächenmontage
(gemeinsame Anode)



Nominal current – Nennstrom	250 mA
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	70 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-23 (TO-236)
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

Maximum ratings

Grenzwerte

Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung		V _{RRM}	70 V
Max. average forward current Dauergrenzstrom	D1 + D2	I _{FAV}	250 mA ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	I _{FRM}	450 mA ¹⁾
Peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	T _j = 25 °C t _p = 1 μs t _p = 1 ms t _p = 1 s	I _{FSM} I _{FSM} I _{FSM}	2 A 1 A 0.5 A
Operating junction temperature – Sperrschiichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T _j T _S	– 50...+ 150 °C – 50...+ 150 °C	

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlaßspannung	T _j = 25 °C I _F = 1 mA I _F = 10 mA I _F = 50 mA I _F = 0.15 A	I _F V _F V _F V _F V _F	< 715 mV < 855 mV < 1.0 V < 1.25 V
Leakage current Sperrstrom	T _j = 25 °C T _j = 150 °C T _j = 150 °C	V _R = V _{RRM} V _R = V _{RRM} V _R = 25 V	< 2.5 μA < 50 μA < 30 μA

¹⁾ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Löt pad) an jedem Anschluß



Junction capacitance
Sperrschiichtkapazität

$$V_F = V_R = 0 \text{ V}$$

$$f = 1 \text{ MHz}$$

$$C_{\text{tot}} < 1.5 \text{ pF}$$

Reverse recovery time
Sperrverzug

$$I_F = 10 \text{ mA über / through}$$

$$I_R = 10 \text{ mA bis / to } I_R = 1 \text{ mA,}$$

$$U_R = 6 \text{ V, } R_L = 100 \Omega$$

$$t_{rr} < 6 \text{ ns}$$

Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschiicht – umgebende Luft

$$R_{\text{thA}} < 320 \text{ K/W}^{-1}$$

